纪小丽 English Version

纪小丽
女，1969.11，硕导，副教授

个人简历：1993年毕业于中科院固体物理所，获硕士学位。1994年8月赴日本筑波大学留学。1998年3月获得工学博士学位。先后在日本筑波大学、京都大学、日本杰伟世公司等机构从事物理材料和器件方面工作。2009年1月起在南京大学电子科学与工程学院从事纳米CMOS器件的可靠性研究。

研究方向：1）纳米CMOS器件可靠性 2）红外光电子器件可靠性 3）超高速成像芯片 4）极弱光成像芯片 5）太赫兹成像芯片 >>>>>>>>>>欢迎有兴趣的本科生，研究生跟我联系>>>>>>>>>>>>>>

主要课程：
信息电子学前沿实验（本科生）

代表成果：

1. The effect of the nitrogen on the energy distribtuion of hole traps generated under Negative Bias Temperature Stress X. Ji, Y. Liao, F. Yan *,Y. Shi,G.ZHANG and Q.GUO IEEE International Reliability Physics Symposium (2012).
2. Worst Case Stress Conditions for Hot Carrier Degradation with Technology Nodes from 0.35μm to 45nm Z.Cheng, X.Ji*, F. Yan ,Y. Shi,G.ZHANG and Q.GUO ECS transaction (2012) accepted.
3. The leakage current improvement of Ni-silicided SiGe/Si junction using a Si cap layer and PAI technique CHANG Jian-Guang,WU Chun-Bo, JI Xiao-Li*, MA Hao-Wen, YAN Feng, SHI Yi, ZHANG Rong Chinese Physics Letters, 29（2012）058501.
4. Direct Experimental Evidence of Hole Trapping in Negative Bias Temperature Instability X. Ji, Y. Liao, F. Yan* ,Y. Shi,G.ZHANG and Q.GUO Chinese Physics Letters, 28（2011）107302.

电话：86-25-83593965
邮件：xji@nju.edu.cn
办公地址：鼓楼校区科技馆1-114

>>> 返回

Copyright 2002-2011 © All Rights Reserverd | 版权所有： 南京大学电子科学与工程学院 © 2002-2011
南京市汉口路22号 210093